
	<h2>SI2306BDS-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI2306BDS-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 3.16A SOT23-3</p> <p>Datenblätter:  SI2306BDS-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 58604 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI2306BDS-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 3.16A SOT23-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	58604 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 3.16A (Ta) 750mW (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	750mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.16A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	47 mOhm @ 3.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.5nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	305pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI2306BDS-T1-E3TR


SI2306BDS-T1-E3 ist neu im Original. Suche SI2306BDS-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2306BDS-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2306BDS-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 SI2306/AO3406 UTC UTC SOT-23	 SI2306CDS-T1-GE3 VISHAY VISHAY SOT23	 SI2306BDS-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 3.16A SOT23-3	 SI2306CDS-T1-E3 VISHAY SI2306CDS-T1-E3 VISHAY
 SI2306BDS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 3.16A SOT23-3	 SI2306BDS-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 3.16A SOT23-3	 SI2306BDS VISHAY SI2306BDS VISHAY	 SI2306BDS-T1 VISHAY SI2306BDS-T1 VISHAY

heiße Teile

Mehr

 SI2304DDS-T1-GE3	 SI2304DDS-T1-GE3	 SI2304DS	 D SI2304DS-T1	 SI2304DS-T1-E3
 SI2304DS-T1-GE3	 SI2305-CDS-T1-GE3	 D SI2305ADS-T1-E3	 SI2305ADS-T1-E3	 SI2305ADS-T1-GE3
 SI2305ADS-T1-GE3	 SI2305BDS-T1-E3	 SI2305BDS-T1-GE3	 SI2305CDS-T1-E3	 SI2305CDS-T1-GE3
 D SI2305CDS-T1-GE3	 SI2305DS	 SI2305DS-E3	 SI2305DS-T1	 SI2305DS-T1-E3
 SI2305DS-T1-E3	 SI2305DS-T1-GE3	 SI2305WCB	 SI2306BDS	 SI2306BDS-T1
 SI2306BDS-T1-E3	 SI2306BDS-T1-GE3	 D SI2306BDS-T1-GE3	 SI2306CDS-T1-E3	 SI2306DS
 SI2306DS-T1	 D SI2306DS-T1-E3	 SI2306DS-T1-GE3	 SI2306WCA	 SI2307BDS
 SI2307BDS-T1-E3	 SI2307BDS-T1-E3	 SI2307BDS-T1-GE3	 SI2307BDS-T1-GE3	 SI2307CDS
 SI2307CDS-T1-E3	 SI2307CDS-T1-E3	 SI2307CDS-T1-GE3	 D SI2307CDS-T1-GE3	 SI2307DS
 SI2307DS-T1	 SI2307DS-T1-E3	 SI2307DS-T1-GE3	 SI2307DS-T7-E3	 SI2308BDS

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited